7=27-21

25B909M 25B1237

エピタキシァルプレーナ形 PNP シリコントランジスタ中電力増幅用/Medium Power Amp.

Epitaxial Planar PNP Silicon Transistors

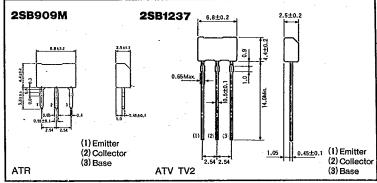
● 特長

- 1) Pc=1Wと大きい。
- 2) V_{CE (sat)}=-0.2V(at-0.5A) と低く, 低電圧動作に適している。
- 3) 2SD1225M/2SD1858とコンプリ。

Features

- 1) High power: Po=1W.
- Low saturation voltage (V_{OE(sat)}=-0.2V at -0.5A). Suitable for use in low-voltage.
- 3) Complementary pair with 2SD1225M, 2SD1858.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit:mm)



注:ATVの外形仕様については、TV3/4/6タイプも用意しています (p.38参照)。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	-40	٧
コレクタ・エミッタ間電圧	VCEO	-32	٧
エミッタ・ベース間電圧	VEBO	-5	٧
コレクタ電流	lo .	1	Α
コレクタ損失	Pc	1	w*
接合部温度	Τj	150	Ç
保存温度範囲	Tstg	−55~150	°

* ブリント基板: コレクタ部分の銅箔面積1cm²以上, 厚み1.7mm

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta=25℃)

Parameter	Symbol	Min.	Тур.	Мах.	Unit	Conditions	
コレクタ・エミッタ降伏電圧	BV _{CEO}	32	_	T -	٧	Ic=-1mA	
コレクタ・ベース降伏電圧	BV _{CBO}	-40	-	_	٧	1c=-50 µA	
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EBO}	– 5		_	٧	I _E =-50 μA	
コレクタしゃ断電流	СВО	_	_	-0.5	μA	V _{CB} =-20V	
エミッタしゃ断電流	IEBO	_	_	-0.5	μA	V _{EB} =-4V	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	VCE(sat)	_	_	-0.5	٧	Ic/IB=-500mA/-50mA*	
直流電流増幅率	hFE	82	-	390	_	VCE /IC=3V/-100mA	
利得帯域幅積 (トランジション周波数)	fT	50	150	_	MHz	Vce =-5V, I ==50mA	
—————————————————————————————————————	Cob		20.	30	pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MH	

* パルス測定

hfeの値により下表のように分類します。

Item P		Q	R	
hre	82~180	120~270	180~390	

-	1## 1# D		34 JA 34 D BE 32	
•	理准品	•	進標進品—覧表	

 	_	*** **** ***
 1示4年00	· () .	準標準品

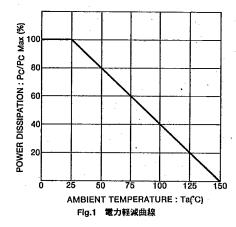
		包装名	バルク	コンテナ	テーピング	
		記号		C2	TV2	TV3
Туре	hFE	基本発注単位(個)	1 000	4 000	2 500	2 500
2SB909M	PQR		0	0	_	
2SB1237	PQR		-	_	0	0

ROHIT

205

T-27-21

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves



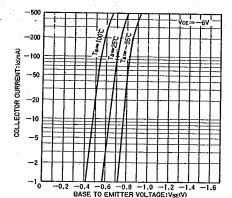


Fig.2 エミッタ接地伝達静特性

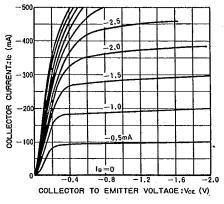


Fig.3 エミッタ接地出力静特性

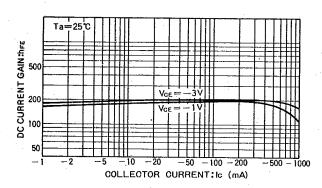


Fig.4 直流電流増幅率一コレクタ電流特性

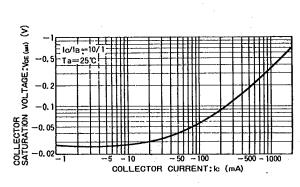


Fig.5 コレクタ・エミッタ飽和電圧一コレクタ電流特性

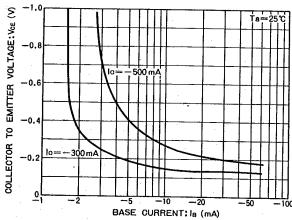
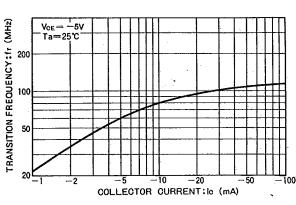
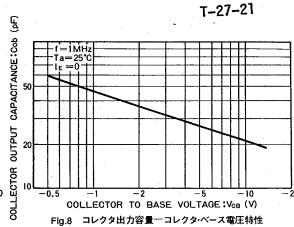


Fig.6 コレクタ・エミッタ電圧ーベース電流特性

206

ROHM





トランジスタ



Fig.7 利得帯域幅積一コレクタ電流特性

